ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДУБНА

13 - 9836

В.Ф.Кушнирук, Ю.П.Харитонов

9836

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-БАРЬЕРНЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ПУЧКЕ ИОНОВ КСЕНОНА

ЭКЗ. ЧИТ. ЗАЛА



13 - 9836

## В.Ф.Кушнирук, Ю.П.Харитонов

# ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-БАРЬЕРНЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ПУЧКЕ ИОНОВ КСЕНОНА

Направлено в ПТЭ



Одновременное измерение кинетической энергии обоих осколков деления /в дополнение к информации о среднем числе нейтронов или рентгеновских лучах/ может существенно помочь идентификации заряда Z<sub>0</sub> делящегося ядра в опытах по поиску сверхтяжелых ядер из предполагаемой области стабильности в районе Z<sub>0</sub> = 114.

Действительно, оценки дают для средней энергии осколков при делении ядра с  $Z_0 \sim 114$  и A ~ 280 значение  $\bar{E}_{KUH.} = 240 \, M_{3}B$ , а для урана эта величина - 168  $M_{3}B$ . "Зазор" в 70  $M_{3}B$  позволяет, в принципе, выделить деление сверхтяжелого элемента на фоне деления урана, который может содержаться в конструкционных материалах установки.

Поскольку относительная дисперсия  $\delta E_{KИH} / E_{E}$  велика /15-20%/, к полупроводниковым детекторам, применяемым в этом случае для измерения энергии, не предъявляется высоких требований в отношении шумов. Гораздо более важным становится вопрос о форме аппаратурной линии спектра, т.к. при регистрации осколков, т.е. частиц с высокой ионизующей способностью, на последнюю могут особенно сильно влиять неоднородность исходного материала детектора /кремния/ и эффекты умножения заряда в детекторе /1,2/.

Поэтому при подготовке в Лаборатории ядерных реакций опытов, направленных на поиск сверхтяжелых элементов, были проведены тщательная проверка и отбор полупроводниковых детекторов с использованием для этой цели моноэнергетического пучка ионов <sup>136</sup> Хе с энергией ~1,1 *МэВ/нуклон*.

3

### Изготовление детекторов и их характеристики

Для изготовления поверхностно-барьерных детекторов использовался бездислокационный, низкоомный /  $\rho$  ~ ~400 Ом.см/ кремний. Рабочая площадь каждого детектора составляла 12 см<sup>2</sup>. Использовались обычно принятые методы подготовки кристаллов. При травлении для защиты базового контакта /осажденный химически никель/ использовалось приспособление, описанное в работе <sup>/3/</sup>. Травление части детекторов проводилось с обеих сторон; в этом случае контактом к базовой области служил напыленный алюминий. В качестве выпрямляющего контакта напылялся слой золота 50-60 мкг/см<sup>2</sup>. В обоих случаях вольтамперные характеристики имели хорошее "плато" до 250-300 В; для лучших образцов обратные токи при комнатной температуре составляли 0,7-1,5 мкА при напряжениях смещения 250-300 В.

Для всех изготовленных детекторов /более 15 штук/ энергетическое разрешение, определенное по регистрацни *а*-частиц с энергией 5,48 *МэВ*, лежало в пределах 65-100 кэВ. Потери энергии во входном окне детектора, измеренные при падении коллимированного пучка *а*-частиц под углами О и 45°, составляли не более 20 кэВ.

Следует подчеркнуть, что аппаратурная линия спектра *a* -частиц во всех случаях имела правильную форму: без "хвостов" и двоений пиков. Однако при спектрометрии ионов Хе(хотя все детекторы /кроме детектора №6/ изготовлены из одного слитка кремния), вид спектра и разрешение сильно различались для разных детекторов.

Экспериментальные результаты на пучке ионов ксенона

Выведенный из циклотрона У-ЗОО пучок ионов<sup>136</sup> Xe<sup>+9</sup>, ускоренных до энергии Е<sub>Xe</sub> = 149 *МэВ*, рассеивался на фольге из сусального золота. Рассеянные под углом 12<sup>°</sup> ионы с энергией 144,5 *МэВ* проходили затем через магнитный сепаратор, в фокальной плоскости которого разрешение по энергин составляло 13 ммна 1% изменения энергни. Перед детектором, расположенным в фокальной плоскости, помещалась щель-коллиматор размерами 4x60 мм, и, таким образом, размытие по энергни ионов, попадающих на детектор не превышало 0,3%.

Сигналы, полученные при регистрации нонов Xe детектором, а также сигнал от генератора точной амплитуды /ГТА/, подключенного ко входу предусилителя, усиливались формирующим усилителем / $r = 1 \ mkc/$  и подавались на 4096-канальный анализатор импульсов. При различных напряжениях на детекторе фиксировались положение /номер канала - N / пика Xe, пика ГТА и ширина /число каналов -  $\Delta N$  / пиков на половине высоты. Ошибки в определении положения и ширины пиков не превышали 0,5 и 10%, соответственно.

Амплитудные спектры и относительное энергетическое разрешение  $R = \Delta N / N$  в зависимости от напряжения смещения приведены на *рис.* 1 и 2.





Отметим основные особенности амплитудных распределений и их дисперсий. Наряду с нормальным видом спектра и ожидаемым улучшением разрешения при увеличении напряжения смещения / рис. 2a/, для некоторых детекторов / рис. 2б/ при напряжениях выше 75 В / поле



Рис. 2. Энергетическое разрешение в зависимости от напряжения на детекторе.

в детекторе  $\bar{\xi} \approx 0,8.10^4 \, B/cm/$  наблюдаются увеличивающийся с напряжением высокоэнергетичный "хвост", иногда даже пик /дет. №6/ и, соответственно, значительное ухудшение разрешения с повышением напряжения. Доля этого высокоэнергичного хвоста достигает иногда 30-50%, а величина аномальных амплитуд может превышать среднюю на 30-45  $M \Rightarrow B / 20-30\%/$ .

Для детектора №5 наблюдается обратная картина: при малых напряжениях заметно удвоение пика, сближение пиков и существенное улучшение разрешения с ростом напряжения.

Интересно проследить корреляцию энергетического разрешения и доли потерь заряда  $\lambda$ , которая зависит

от напряженности поля  $\bar{\mathcal{E}}$  в детекторе /  $\bar{\lambda} = \frac{Q_0 - Q}{Q_0}$ ,

 $Q_0$  - заряд, генерированный в чувствительном слое детектора,  $\bar{Q}$  - средний собранный заряд/.

При напряженностях поля, при которых еще не достигается насыщения дрейфовой скорости носителей,  $\lambda - \frac{1}{\bar{E}} - \frac{1}{\sqrt{U}}$  / U - напряжение на детекторе/. Следовательно, при малых полях  $\bar{Q} = Q_0 - \frac{\text{const}}{\sqrt{U}}$ . Построив по результатам измерений зависимость  $\bar{N} = F (1/\sqrt{U})$ / $\bar{N}$  - номер канала центра амплитудного распределения/ и экстраполируя к  $1/\sqrt{U} = 0$  прямолинейный участок, определяем  $N_0 - Q_0$ . После этого для каждого напряжения смещения определяем  $\bar{\lambda} = -\frac{N_0 - \bar{N}}{N}$ . Следует отметить одно обстоятельство, связанное с процедурой определе-

ния  $\overline{\lambda}$  при каждом напряжении: так как емкости использованных нами детекторов велики и меняются в широких пределах /от 650<sup>4</sup>до 2300 *пф*/ при изменении напряжения смещения, то коэффициент преобразования генерированного заряда в амплитуду нельзя считать независимым от емкости детектора, а, следовательно, и от напряжения смещения.

Чтобы привести все результаты к единому коэффициенту преобразования, вводилась прправка по генератору точной амплитуды. Новые значения номеров каналов N'рассчитывались по формуле:

$$I' = N \frac{N *_{\Gamma TA}}{N_{\Gamma TA}},$$

Ęą.

где N, N<sub>ГТА</sub> - номера каналов анализатора для пиков ксенона и генератора, соответствующие одному из напряжений на детекторе; N $_{\Gamma TA}^*$  - номер канала ГТА при напряжении U\* = 225 *В*/заметим, что вкачестве U\*можно зафиксировать любое напряжение/. Поправленные таким образом значения N' и использовались при определении средних потерь  $\overline{\lambda}$  при каждом напряжении смещения.

На *рис.* 3 представлены значения  $\frac{Q}{Q_0} = 1 - \overline{\lambda}$  в зави-

симости от напряжения для девяти детекторов.



Рис. 3. Доля собранного заряда в зависимости от смещения.

После получения  $\overline{\lambda}$  для каждого из измерений мы можем сопоставить экспериментальные значения разрешения R и параметра  $\overline{\lambda}(1-\overline{\lambda})^{-1}$ . Выбор этого параметра объясняется ниже при анализе результатов. Такое сопоставление приведено на *рис.* 4, где нанесены значения разрешений при напряжении 25 *B* - для детекторов 2,4, 5,7,9 и для различных напряжений /тех, при которых



Рис. 4. Энергетическое разрешение в зависимости от параметра  $\lambda(1-\lambda)^{-1}$ ;  $\lambda$  - относительные потери. • - детекторы NN22,4,5,7,9 при напряжении смещения - 25 В; • - детектор N66, × - детектор N23,  $\lambda$  - детектор N21 при различных напряжениях.

разрешение не достигает насыщения/ - для детекторов 1,3,6. При измерениях, когда источник расположен близко к детектору и реализуются различные углы падения частицы на детектор, важной характеристикой его является зависимость дополнительных потерь заряда /по сравнению с перпендикулярным падением/ от угла входа.

На *рис.* 5 представлен результат измерения амплитуды /номера канала/ пика ксенона в зависимости от  $\sec \theta$ , где  $\theta$  - угол между направлением пучка и нормалью к плоскости детектора, а в таблице даны энергетические сдвиги, вычисленные по данным *рис.* 5, в зависимости от угла.



Рис. 5. Зависимость амплитуды от угла падения ионов на детектор.

65° 55° 20° 40° 45° 35° θ 10 18  $E/M \rightarrow B/O.4$ 2,4 3,5 4,5

Из измерений мертвого слоя с помощью *a* -частиц, следует, что этот слой состоит из 60 *мкг/см*<sup>2</sup> золота и  $\leq 0,1$  *мкм* кремния. В таком случае сдвиг ксенонового пика при 45° должен быть ~0,75 *МэВ*, а наблюдаемая величина больше примерно в 6 раз. Об увеличении эффективного мертвого слоя для тяжелых ионов в 5-10 раз /по сравнению с *a*-частицами/ говорилось и ранее<sup>/4/</sup>. Из полученных данных следует, что при нормальном падении пучка потеря заряда в "эффективном" мертвом слое составляет ≈12 *МэВ*, т.е. основные потери происходят вблизи поверхностп детектора.

#### Обсуждение результатов

При регистрации ионов ксенона с энергией  $1 M_{3}B/нукл.$ прежде всего обращает на себя внимание очень значительная потеря заряда, особенно при напряженностях поля в детекторе до  $10^4 B/cm / puc. 3/$ . При дальнейшем повышении напряженности поля собранный заряд растет незначительно, и для большинства исследованных детекторов потери /остаточный дефект/ составляют 5-10 M<sub>3</sub>B. Сильная зависимость от напряженности и наблюдаемый эффективный "мертвый слой" ~ 1 *мкм* свидетельствуют в пользу предположения о рекомбинационном характере потерь и о локализации их вблизи поверхности. Наблюдаемые значения остаточного дефекта /5-10 M<sub>3</sub>B/ в среднем неплохо согласуются с величиной E<sub>OCT</sub> = 7 M<sub>3</sub>B, вычисленной по полуэмпирической формуле:

$$E_{oct} = 3,47 \cdot 10^{-3} \left( \frac{dE}{dx} - \frac{dE}{dx_{KP}} \right)$$
 (Z-11).

Формула предложена Стейнбергом и др.  $^{/5/}$  по результатам измерений дефекта для различных ионов с удельными потерями до 35  $M \ni B/mz.cm^{-2}$  /в нашем случае удельные потери выше, dE / dx = 52  $M \ni B/mz.cm^{-2}$  /. Отметим, однако, значительно большие, чем 7  $M \ni B$ , дефекты для детекторов №5 и 6 /рис. 3/.

Для анализа полученных результатов по разрешению необходимо знать и другие потери заряда, не приводящие к генерации электронно-дырочных пар в чувствительном слое детектора:

а/ потери, связанные с ядерными столкновениями атомов ксенона с атомами кремния -  $\Delta E_{\rm яд.} \simeq 3,7 \ M \Rightarrow B$ /рассчитаны по работе Вилкинса и др. /6/ /;

2/ потери энергии в 60 *мкг/см* золота/входное окно/  $\Delta E_{A_{II}} = 1,2 M_{3}B^{/8/}$ .

Соответствующие флуктуации собранного заряда составляют 1,35 *МэВ*<sup>/9/</sup> и ≤ 0,4 *МэВ*.

Рассчитанный суммарный вклад в разрешение за счет не связанных с напряжением потерь заряда и с учетом размытия первичного пучка ксенона /~ 0,3%/ составляет ~ 1%.

Ход кривых энергетического разрешения при напряженнях до 75 В /рис. 2а,б/ качественно объясняется улучшением собирания заряда / рис. 3/. Однако очевидно, что даже самые большие потери  $/\lambda = 0,3-0,4/$  не объясняют наблюдаемых значений разрешения, если считать потери однородными по всей площади детектора. Действительно, для  $\overline{\lambda} = 0,4$ , относительная флуктуация

собранного заряда  $\frac{2,35 \sqrt{\lambda} E \in}{(1-\overline{\lambda})E} \approx 4 \cdot 10^{-4} / E = 145 M з B,$  $(= 3,5 \ з B/, B$  то время как относительное разрешение

при этом составляет 10% / 
$$\frac{\delta Q}{\bar{Q}} = 0,1/.$$

Естественно предположить, что параметр потерьλ имеет некоторую дисперсию δλ, связанную с неодиородностью времени жизни и удельного сопротивления по площади детектора. Легко показать, что относительная

дисперсия собранного заряда  $\frac{\delta Q}{\bar{Q}} = \frac{\sqrt{\bar{Q}^2 - (\bar{Q})^2}}{\bar{Q}}$  в этом случае выражается через  $\lambda$  и  $\delta\lambda$  следующей формулой:

$$\frac{\delta Q}{\bar{Q}} = R_{\lambda} \frac{\bar{\lambda}}{1 - \bar{\lambda}},$$

где  $R_{\lambda} = \frac{\delta \lambda}{\overline{\lambda}}$  - относительная дисперсия средней потери  $\overline{\lambda}$ .

Если другие вклады в разрешение малы /а это так,

по крайней мере, при больших  $\overline{\lambda}$  /, то дисперсия  $\frac{\delta Q}{\overline{\Omega}}$ и есть наблюдаемое на опыте относительное разрешение. Характер зависимости разрешения R от параметра  $\overline{\lambda}(1-\overline{\lambda})^{-1}$ полученной по нашим измерениям / рис.4/ подтверждает пропорциональность R –  $\overline{\lambda}$   $(1-\overline{\lambda})^{-1}$ , и для объяснения наблюдаемых значений необходимо предположить относительный разброс потерь ( $R_{\lambda} = \frac{\delta \lambda}{\Sigma}$ ) около 20%.

При напряженностях поля  $\bar{\mathcal{E}} > 10^4 \ B/cM$  потери для различных детекторов /кроме №5 и 6/ составляют  $\bar{\lambda}$ ~О.1 и меняются слабо. Соответственно разрешение либо не меняется / рис. 2а/, либо ухудшается для тех детекторов, у которых наблюдается появление "хвоста" со стороны больших энергий / рис. 26/.

Появление аномально больших амплитуд при регистрации осколков деления наблюдали различные авторы /1,2,7/. На монохроматических ионах этот эффект особенно четко проявляется / рис. 1/. По результатам измерений можно сделать следующие качественные выводы:

1/ доля аномально больших амплитуд в спектре растет приблизительно линейно с напряжением, максимальная "усиленная" амплитуда - несколько медленнее:

2/ при напряжениях меньше 70 В эффект усиления очень незначителен или отсутствует;

3/ на детекторах с наилучшими барьерами /обратные токи ≤ 1 мкА при 200-300 В/ эффект усиления не проявляется даже при самых высоких напряжениях.

Для окончательной оценки возможностей спектрометрии осколков в реальных условиях на "сэндвиче" из двух детекторов площадью 12 см<sup>2</sup> каждый снят двумерный спектр осколков деления <sup>235</sup>U тепловыми нейтронами / рис. 6/. Расстояние между детекторами - 7 мм. <sup>235</sup> U был нанесен на майларовую подложку~150 мкг/см<sup>2</sup> и закрыт пленкой такой же толщины. Доля отсчетов лежащих выше линий E<sub>k</sub> = 200 МэВ составила не более  $5.10^{-4}$  от общего числа импульсов.

В заключение авторы благодарят Ю.Ц.Оганесяна за постановку задачи, А.Г.Артюха, обеспечившего работу сепаратора; С.М.Соловьева за существенную помощь и советы при подготовке работы и О.А.Орлову, подготовившую измерения спектра деления.

and the second second



Рис. 6. Двумерный спектр осколков деления <sup>235</sup>U тепловыми нейтронами. Число отсчетов в каналах: • больше 1200, сечения даны для 1/2, 1/4 и т.д. от этой величины.

#### Литература

- 1. F.J. Walter. IEEE Trans., NS-11, No. 3, 232 /1964/.
- 2. С.М.Соловьев, В.П.Эйсмонт. Прикладная ядерная спектроскопия, вып. 3/1972/, стр. 201.
- 3. С.М.Соловьев. Прикладная ядерная спектроскопия, вып. 4 /1974/, стр. 105.
- 4. E.Konecny and K.Hetwer. Nucl.Instr. and Meth., 36, 61 /1965/.
- 5. E.P.Steinberg et al. Nucl. Instr. and Meth., 99, 309 /1972/.

- 6. B.D. Wilkins et al. Nucl. Instr. and Meth., 92, 381 /1971/.
- 7. Е.Бельцаж, П.Сифферт. Рабочее совещание по полупроводниковым детекторам. Дубна, 1974, 13-7990, стр. 21.
- L.C.Northcliffe and R.E.Schilling. Nucl. Data Tables, A7, No. 3-4, 233 /1970/.
  E.L.Haines and A.B.Whitehead. Rev.Sci. Instr.,
- E.L.Haines and A.B.Whitehead. Rev.Sci. Instr., 37, No. 2, 190 /1966/.

Рукопись поступила в издательский отдел

2 июня 1976 года.